

課題番号 : F-12-WS-0043  
支援課題名 (日本語) : Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>パッシベーションを施した水素終端ダイヤモンドMOSFETの作製および評価  
Program Title (in English) : Fabrication and evaluation of H-terminated diamond MOSFET with Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> passivation  
利用者名 (日本語) : 坪井 秀俊  
Username (in English) : Hidetoshi Tsuboi  
所属名 (日本語) : 早稲田大学 先進理工学部  
Affiliation (in English) : School of Fundamental Science and Engineering, Waseda University

概要 (Summary) :

水素終端ダイヤモンド表面にパッシベーションを施すことにより、従来の水素終端ダイヤモンドFETでは不可能だった高温環境でも動作可能なMOSFETの作製を目指す。

相談の結果、このパッシベーション膜の形成には、Picosun社製ALD装置を用いたAl<sub>2</sub>O<sub>3</sub>膜の使用が適すると考えられ、これの利用を検討する。

関連特許 (Patent) :

なし。

実験 (Experimental) :

なし。

結果と考察 (Results and Discussion) :

なし。

その他・特記事項 (Others) :

なし。

共同研究者等 (Coauthor) :

なし。

論文・学会発表

(Publication/Presentation) :

なし。